



中科海高
HiGaAs Microwave

V2.1

HGC136-2A

GaAs MMIC
均衡器芯片, 18 - 40 GHz

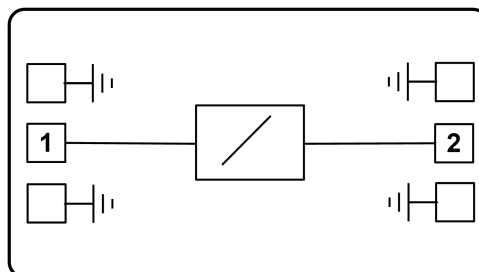
6

均衡器
|
裸芯片

主要特点

频率范围: 18 - 40 GHz
插入损耗: 1.6 dB @ 40 GHz
均衡量: 2 dB
输入输出回波损耗: 18 dB
芯片尺寸: $0.85 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

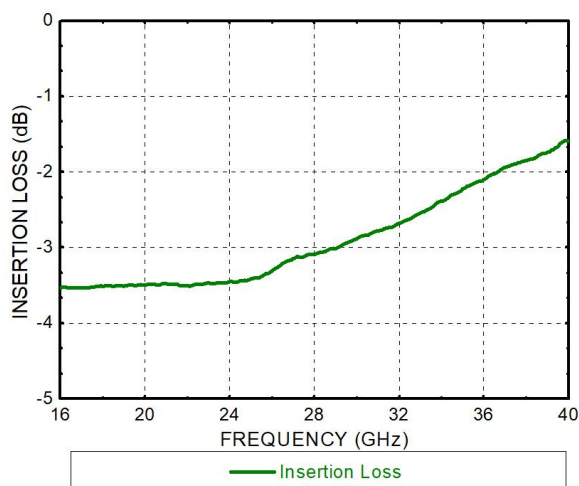
功能框图



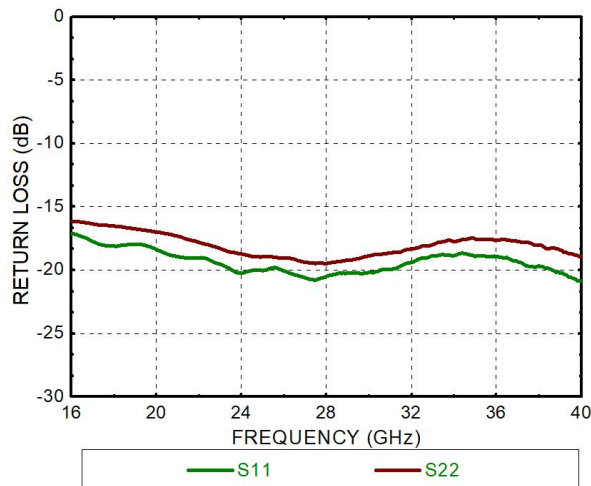
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	18-40			GHz
插入损耗@40GHz		1.6		dB
均衡量		2		dB
回波损耗		18		dB

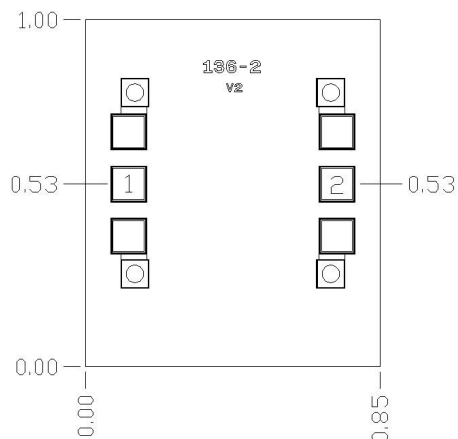
插入损耗



回波损耗



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频输入/输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果外部射频电压不是 0V, 那么需要外接隔直电容



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 μm^2
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.3 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$